		173	Поз. обозна- чение	Наименование	ол. Примечание		
C6-C7 GRY2BYTHISKA 121, quyun Murata Manufacturing Rinnums 2	.ПМЕН.	00.61					
C6-C7 GRY2BYTHISKA 121, quyun Murata Manufacturing Rinnums 2	л да	,6834		<u>Конденсаторы</u>			
C6-C7 GRY2BYTHISKA 121, quyun Murata Manufacturing Rinnums 2	ΠE	EYH.4	(2, (5	CDM24DD741401 VA 04V Avenue Minate Manufacturio	on Chause	2	
CO_CTI GRN20878H05KAQW, qupma Murata Manufacturing, Rnown		β		· '			
C12.C13 GRN2/BR77H54K, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп изд C14 GRN2/BR79H05KA12L, фирма Murata Manufacturing, Япания 1 имп изд C15 GRN2/BR79H0KA0K, фирма Murata Manufacturing, Япания 1 имп изд C16-C23 GRN2/BR79H0KA0K, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп изд C26,C27 CC006SRRX/RP98B172 фирма Yageo, Taidbans 2 имп изд C28,C29 CC006SRRX/RP98B172 фирма Yageo, Taidbans 2 имп изд C30-C41 GRN2/BR7H0AVA0MK, фирма Sansung, Япания 12 имп изд C42-C49 GRN2/BR7H0AVA0MK, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп изд C50,C51 GRN2/BR7H0AVA0MK, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп изд C54,C55 GRN2/BR7H0AVA0MK, фирма Sansung, Япания 1 имп изд C54,C55 GRN2/BR7H0AVA0MK, фирма Sansung, Япания 2 имп изд D041 L78633ABUTR, фирма STMcroelectronics, Швейцария 1 имп изд D05-D03 SN74H625DR, фирма STMcroelectronics, Швейцария 1 имп изд D03 SN74H625DR, фирма STMcroelectronics	Н		•				
СК 67M2-8877H/OSKA/2L, фирма Marata Manufacturing, Япония 1 имп. изд СБ GRM2-8873H/O4KAOIK, фирма Sonssing, Япония 1 имп. изд СБ GRM2-8873H/O4KAOIK, фирма Sonssing, Япония 8 имп. изд СС4-С25 G13872SFGHNNME, фирма Sonssing, Япония 2 имп. изд С24-С25 СС000SRMP090N/TQ фирма Toppea Tabbanh 2 имп. изд С26-С27 С1288226KO,INNME, фирма Sonssing, Япония 12 имп. изд С30-С41 С1288226KO,INNME, фирма Sonssing, Япония 2 имп. изд С50-С51 GRM2-887HH03-KAOIR, фирма Sonssing, Япония 2 имп. изд С50-С53 GRM2-887H03-KAOIR, фирма Sonssing, Япония 2 имп. изд С50-С53 GRM2-887H03-KAOIR, фирма Sonssing, Япония 2 имп. изд С50-С67 С1228-686-BANNME, фирма Sonssing, Япония 2 имп. изд С56-С67 С132802-26KO,INNME, фирма Sonssing, Япония 1 имп. изд Вирма Соборовой Карай Кар	Ш			. , ,			
C15 GRM218R71H10LKAOIK, фирма Nurata Manufacturing, Япония							
C16-C23 G.3.16272KGHNMKE, qupma Samsung Shahus 8 um usid C2k,C25 GRM2RR7HNO4KADK, qupma Murata Manufacturing, Rhahus 2 um usid um usid C2k,C27 CC0805KRXR98B472, qupma Yageo, Taidanь 2 um usid C2k,C27 CC0805KRXR98B472, qupma Yageo, Taidanь 2 um usid C30-C41 CI.328226KDNMNE, qupma Samsung Rhahus 12 um usid C30,C51 GRM2RR7HNUKADK, qupma Samsung Rhahus 12 um usid C50,C51 GRM2RR7HNUKADK, qupma Samsung Rhahus 2 um usid C50,C51 GRM2RR7HNUKADID, qupma Murata Manufacturing, Shahus 2 um usid C54,C55 CI.21CSR6CBANNK, qupma Samsung, Rhahus 2 um usid C54,C55 CI.21CSR6CBANNK, qupma Samsung, Rhahus 12 um usid C56-C67 CI.328226KD.NNNE, qupma Samsung, Rhahus 12 um usid C56-C67 CI.32826KD.NNNE, qupma Samsung, Rhahus 12 um usid C56-C67 CI.32826KD.NNNE, qupma Samsung Rhahus 12 um usid Um usid C56-C67 CI.32826KD.NNNE, qupma Samsung Rhahus 14 um usid C56-C67 CI.32826KD.NNNE, qupma Samsung Rhahus 1 um usid C56-C67 C5	ab. Nº			· · ·			
C24,C25 БRM218R71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing Япания 2 имп изд C26,C27 CC0805RRNP098N470, фирма Yageo, Taúbanь 2 имп изд C30-C41 C122222660 NNNIC, фирма Samsung Япания 12 имп изд C42-C49 C138D25R6NNNIC, фирма Samsung, Япания 12 имп изд C50-C51 GRM218R71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп изд C50-C53 GRM218R71H02KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп изд C52-C53 GRM218R7H02KA01K, фирма Samsung, Япания 2 имп изд C54-C55 CL21C5R6CBANNIC, фирма Samsung, Япания 2 имп изд C56-C67 CL328226K0.INNIC, фирма Samsung, Япания 12 имп изд D04 L76L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцария 1 имп изд D01(D02 VINSD16A1TR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария 1 имп изд D03 SN74HC125OR, фирма STMicroelectronics, Швейцария 1 имп изд D04 LTC29541S8-2, фирма Texas Instruments, CША 1 имп изд В05 Предокранители плавкие 1 имп изд В06 КИК 1	Jduj				_		
C26,C27 ССОВОБККХХТЯРВВ4 72, фирма Yagea, Тайдань 2 имп изд C28,C29 ССОВОБ КПРОЭВНА 70, фирма Yagea, Тайдань 2 имп изд C30-E41 C1328226KD,NNNE, фирма Samsung, Япония 12 имп изд C42-C49 C138225KBHNNE, фирма Samsung, Япония 2 имп изд C50,C51 GRM2/BR71H04KAOK, фирма Murata Manufacturing, Япония 2 имп изд C52,C53 GRM2/BR71H04KAOK, фирма Samsung, Япония 2 имп изд C54,C55 C1.215SR6CBANNE, фирма Samsung, Япония 2 имп изд C56-C67 C1.328226KD,NNNE, фирма Samsung, Япония 12 имп изд В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	Ш						
C28,C29 CC0805,RNP09BN470, фирма Yageo, Taübane 2 имп изд C30-C41 CL32B226KD,MNME, фирма Samsung, Япания 12 имп изд C42-C49 CL38B225KB,MNME, фирма Samsung, Япания 8 имп изд C50,C51 GRM28BR78H04KAOIK, фирма Mundata Manufacturing, Япания 2 имп изд C52,C53 GRM26BR78H02KXAOID, фирма Mundata Manufacturing, Япания 2 имп изд C54,C55 CL21CSR6CBANINE, фирма Samsung, Япания 12 имп изд C56-C67 CL32B226KO,MNME, фирма Samsung, Япания 12 имп изд Микрасхемы 12 имп изд 12 имп изд D010D2 VM506A-IR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария 1 имп изд D03 SN74HC1250R, фирма STMicroelectronics, Швейцария 1 имп изд D04 LTC2954ITS8-2, фирма Anatog Devices, США 1 имп изд E6 Предохранители плавкие 1 имп изд E7 KLSS-1046-25000, фирма SIBA, Германия 1 имп изд FU3 RVA MF-MSNF050, фирма SIBA, Германия 1 имп изд E8 FU3 RVA MF-MSNF050, фирма SIBA, Германия 1	Ш			<u> </u>	<u> </u>		
12	ш						
C42-C49 [L318225KBHNNNE, фирма Samsung, Япония 8 имп изд C50.C51 GRM28R71H104KA01K, фирма Murata Manufacturing, Япония 2 имп изд C52,C53 GRM216R71H82ZKA01D, фирма Murata Manufacturing, Япония 2 имп изд C54,C55 CL21C5R6CBANNNE, фирма Samsung, Япония 12 имп изд C56-C67 G1328226KD,NNNE, фирма Samsung, Япония 12 имп изд Микросхены 1 имп изд 12 имп изд D01,002 WSD16A1TR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария 2 имп изд D03 SN74KC125RR, фирма NNP Semiconductors, Нидерианды 1 имп изд D04 LTC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, США 1 имп изд D05-008 TPS545600DAR, фирма Texas Instruments, США 4 имп изд FU1 189000 15, фирма SIBA, Германия 1 имп изд FU3-FU4 MF-MSM6050, фирма Bourns, США 2 имп изд FU3-FU3-FU4 MF-MSM6050, фирма Bourns, США 2 имп изд							
C50,C51 GRM2/BR7/H104KAO/K, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп. изд C52,C53 GRM2/GR7/H822KAO/D, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп. изд C54,C55 CL2/C5R6CBANNIX, фирма Samsung, Япания 2 имп. изд C56-C67 CL32B226KO,INNIE, фирма Samsung, Япания 12 имп. изд Микросхемы 12 имп. изд В Дим изд 001,002 VM5016A/IR-E, фирма STMicroelectronics, Шбейцария 1 имп. изд D03 SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Индерланды 1 имп. изд D04 LTC2954ITSB-2, фирма Analog Devices, США 1 имп. изд D05-D08 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 имп. изд В Дредохранители пладжие 1 имп. изд FU1 189000 15, фирма SIBA, Германия 1 имп. изд FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай 1 имп. изд FU3,FU4 MF-MSM-F050, фирма Bourns, США 2 имп. изд							
C52(C53 GRM2/6R71/H822KAD1D, фирма Murata Manufacturing, Япания 2 имп. изд							
C54,C55 C12/C5R6CBANNNC, фирма Samsung, Япония 2				· '	<i></i>		
C56-C67 CL328226KO.ININNE, фирма Samsung, Япония 12 имп. изд Микросхемы Видей при			-		_		
Микросхемы DA1 L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцария 1 имп. изд. DD1,DD2 VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария 2 имп. изд. DD3 SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды 1 имп. изд. DD4 LTC29541TS8-2, фирма Analog Devices, США 1 имп. изд. D05-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 имп. изд. Предохранители плавкие 1 имп. изд. FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия 1 имп. изд. FU2 KLS5-1046-25000, фирма Bourns, США 2 имп. изд. FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 имп. изд.			-				
DA1 L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцария DD1,DD2 VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария DD3 SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды DD4 LTC29541TS8-2, фирма Analog Devices, США DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 UMN U3д DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 UMN U3д FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 UMN U3д FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 UMN U3д				٠١١ ک			
DA1 L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцария DD1DD2 VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария DB3 SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды DB4 LTC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, США DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 UMN U3d DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 UMN U3d FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай FU3FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 UMN U3d FU3FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 UMN U3d 2 UMN U3d 2 UMN U3d 2 UMN U3d 4 UMN U3d							
DA1 L78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцария DD1DD2 VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария DB3 SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды DB4 LTC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, США DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 UMN U3d DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 UMN U3d FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай FU3FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 UMN U3d FU3FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 UMN U3d 2 UMN U3d 2 UMN U3d 2 UMN U3d 4 UMN U3d				<i>Микросхемы</i>			
DD1,DD2 VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария 2 имп. изд. DD3 SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды 1 имп. изд. DD4 LTC29541TSB-2, фирма Analog Devices, США 1 имп. изд. DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 имп. изд. УВЕН В БИЗ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В							
DD1,DD2 VN5016AJTR-E, фирма STMicroelectronics, Швейцария DD3 SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды DD4 LTC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, США DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США 4 Uмп. изд. Предохранители плавкие FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Bourns, США 2 имп. изд. 2 имп. изд. 1 имп. изд. 1 имп. изд. 2 имп. изд.			DA1	78L33ABUTR, фирма STMicroelectronics, Швейцар	ПИЯ	1 имп. изд.	
DD4 LTC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, CWA DD5-DD8 TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, CWA LTC2954ITS8-2, фирма LTC2954ITS8-2, фирма Texas Instruments, CWA LTC2954ITS8-2, фирма LTC2954ITS8-2, фирма LTC2954ITS8-2, WART LTC2954ITS			DD1,DD2			2 имп. изд.	
DD5-DD8 TPSS4560DDAR, фирма Texas Instruments, США Inpedoxpanumenu nnabkue			DD3	SN74HC125DR, фирма NXP Semiconductors, Нидерл	анды	1 имп. изд.	
Предохранители плавкие FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай 1 имп. изд. FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Воигпs, США 2 имп. изд.			DD4	TC2954ITS8-2, фирма Analog Devices, США		1 имп. изд.	
Предохранители плавкие FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай 1 имп. изд. FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Воигпs, США 2 имп. изд.	дата		DD5-DD8	TPS54560DDAR, фирма Texas Instruments, США		4 имп. изд.	
Предохранители плавкие FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай 1 имп. изд. FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Воигпs, США 2 имп. изд.	N° лодл. Подл. и дата Взам. инв. N° дубл. Подп. и дата						
FU1 189000.15, фирма SIBA, Германия 1 имп. изд. FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай 1 имп. изд. FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Воигпs, США 2 имп. изд.	Ш						
FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай 1 имп. изд. FU3,FU4 МF-MSMF050, фирма Воигля, США 2 имп. изд.	ıδn.			Предохранители плав.	KUP		
FU2 KLS5-1046-25000, фирма KLS electronic, Китай 1 имп. изд. FU3,FU4 МF-MSMF050, фирма Воигля, США 2 имп. изд.	Nº dy						
дел жев FU3,FU4 MF-MSMF050, фирма Воигля, США 2 имп. изд.	Инв. Л		FU1	189000.15, фирма SIBA, Германия		1 имп. изд.	
1 Jogun n dgma	No		FU2	KLS5–1046–25000, фирма KLS electronic, Китай		1 имп. изд.	
1 Jogun n dgma	инв.		FU3,FU4	MF-MSMF050, фирма Bourns, США		2 имп. изд.	
	и дата						
					Т		
ргун 1. 3ам Ргун 1-2023 пада 080623 РГУН 1. 6.8 3 /. 9 ЛОТ ПЭЗ ТЭ							
1 3nm PF9H1-2023 nndn 1080623 PF9H7-6837-911111-13-1-1-	Подп				DELILI / 403 / 0 004		
7 Зай ТЕЗП.140034 У.ООТ ПЭЭ ТЭ Изм. Лист № докум. Подп. Дата			1 Зам Изм. Лист		PL 9H.46834 9.UU1	לו צלוו	
Pagnat Madagguuri pada 08.06.23 Aum Augmah	дл.		Разраб. Г.	<u>длесный</u> подп. 08.06.23		Num. Nucm Nucmol	ß
Пров. Шавликов подп. 08.06.23 Плата распределения питания	Nº no.			Tinuina put	пределения питания	1 1 / 4	
Н.контр Мирошников подп. 08.06.23 Утв. Шавликов подп. 08.06.23 Перечень элементов	ОНЮ				печень элементов		

Поз. обозно чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Катушки индуктивности	+	
1112	D02/775/453M000 4 FD505 5		
L1,L2	B82477G4153M000, фирма EPCOS, Германия	2	имп. изд.
	B82477G4333M000, фирма EPCOS, Германия	1	имп. изд.
<u>L4</u>	B82477G4823M000, фирма EPCOS, Германия	1	имп. изд.
	Резисторы		
	т езисторы		
R1,R2	RCO805FR-07100RL, фирма Yaqeo, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>
R3-R6	RCO805FR-0710KL, фирма Yaqeo, Тайвань	4	<u>имп. изд.</u>
R7,R8	RCO805FR-072K7, фирма Yaqeo, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>
R9,R10	RCO805FR-077K5 фирма Yaqeo, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>
R11-R14	RCO805FR-0710KL, фирма Yaqeo, Тайвань	4	<u>имп. изд.</u>
R15,R16	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
R17,R18	RCO805FR-0710KL, фирма Yaqeo, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>
, R19	RCO805FR-07100RL, фирма Yageo, Тайвань	1	<u>имп. изд.</u>
R20	RCO805FR-0710KL, фирма Yaqeo, Тайвань	1	 имп. изд.
R21	RCO805FR-07100RL, фирма Yaqeo, Тайвань	1	 имп. изд.
R22,R23	RCO805FR-0710KL, фирма Yaqeo, Тайвань	2	 имп. изд.
R24	RCO805FR-07100KL, фирма Yaqeo, Тайвань	1	 имп. изд.
R25	RCO805FR-07100RL, фирма Yaqeo, Тайвань	1	 имп. изд.
R26,R27	RCO805FR-070RL, фирма Yaqeo, Тайвань	2	 имп. изд.
R28,R29	RCO805FR-07243KL, фирма Yaqeo, Тайвань	2	 имп. изд.
R30,R31	RCO805FR-0716K9L, фирма Үадео, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>
R32,R33	RCO805FR-07330RL, фирма Yaqeo, Тайвань	2	<u>имп. изд.</u>
R34	RCO805FR-0753K6L, фирма Yaqeo, Тайвань	1	<u>имп. изд.</u>
R35	RCO805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	<u>имп. изд.</u>
R36	RCO805FR-0753K6L, фирма Yaqeo, Тайвань	1	<u>имп. изд.</u>
R37	RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
R38,R39	RCO805FR-070RL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
R40,R41	RC0805FR-07243KL, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
R42,R43	RCO805FR-0723K7L, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
R44,R45	RCO805FR-071K2, фирма Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
R46	RCO805FR-07143KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
R47	RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
R48	RCO805FR-07143KL, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
R49	RC0805FR-0710K2L, фирма Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	<u> Диоды</u>		
VD1-VD4	SM15T36A, фирма STMicroelectronics, Швейцария 4		имп. изд.
	PEYH.468349.001	ПЭЗ ТЭ	/lucm
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	·= - · -	2

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Вэам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

		Кол.	Примечание
	TO–1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Kumaū	2	имп. изд.
VD7, VD8 VD9, VD10 VD11, VD12 VD13, VD14 VD16, VD17 VD18, VD19 VD22, VD23 VD24, VD25 VD26, VD27 VT1, VT2 VT3, VT4 X1, X2 X3-X8 X9-X12 X13, X14	PMEG3010BEA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
VD5, VD6 VD7, VD8 VD9, VD10 VD11, VD12 VD13, VD14 VD15 VD16, VD17 VD20, VD21 VD22, VD23 VD24, VD25 VD26, VD27 VT1, VT2 VT3, VT4 X1, X2 X3-X8 X9-X12 X13, X14	SMAJ15A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
· ·	SMAJ24A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
VD13, VD14	PESD5VOL1BA,115, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
VD15	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	1	имп. изд.
<i>VD16,VD17</i>	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	имп. изд.
	TO–1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	имп. изд.
VD20, VD21	SMBJ5.A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
<i>VD22,VD23</i>	B56OC, фирма Diodes Incorporated, США	2	имп. изд.
VD24, VD25	TO-1608BC-PG, фирма Taiwan Oasis Technology Co., Ltd, Китай	2	имп. изд.
<i>VD26, VD27</i>	SMBJ12A, фирма STMicroelectronics, Швейцария	2	имп. изд.
	<u>Транзисторы</u>		
VT1,VT2	IRF7509TRPBF, фирма Infineon Technologies, Германия	2	имп. изд.
VT3,VT4	BSH103,215, фирма NXP Semiconductors, Нидерланды	2	имп. изд.
	<u>Соединения контактные</u>		
X1,X2	XT60-M.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	имп. изд.
X3-X8	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Kumaū	6	имп. изд.
X9-X12	DS1069-4MVW6X, фирма Connfly, Kumaū	4	имп. изд.
X13,X14	XT60-F.G2.Y, фирма Amass Electronics, Китай	2	имп. изд.
VD7, VD8 VD9, VD10 VD13, VD14 VD16, VD17 VD18, VD21 VD22, VD23 VD26, VD27 VT1, VT2 VT3, VT4 X3-X8 X9-X12 X13, X14 X15, X16 X10, X10 X10, X11 X10, X12 X13, X14 X15, X16	DS1066-2MVW6X, фирма Connfly, Китай	2	имп. изд.
	РЕУН.468349.001 Г. № докум. Подп. Дата	193 T3	7 /ист

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

	Номера листов (страниц)				Всего		Входящи <u>й</u> №		
Изм.	ИЗМЕНЕН- НЫХ	ЗАМЕНЕН- НЫХ	новых	аннули- рован- ных	листов (страниц) в докум.	№ докум.	сопроводи- тельного документа и дата	Под- пись	Дат
				1					\vdash
									╁
									—
									
				1					
									
								_	
									<u> </u>
									\vdash
				1					
				1					_
				1					\vdash
									\vdash
				_					<u> </u>
									_
				1					\vdash
									
									<u> </u>
									_
				1					\vdash
				1					-
				1					T
									_
				1			+ -		+
				1					+
丁				-	PEYH.46				ſΙ

Подп. и дата

Взам. инв.№ Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.